

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 510 601 B9

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:

Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe Seite(n) 3
Zahlreiche Schreibfehler geringer Bedeutung

(51) Int Cl.:

C25D 17/00 (2006.01) **C25D 7/12** (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:

15.11.2006 Patentblatt 2006/46

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des

Hinweises auf die Patenterteilung:

01.03.2006 Patentblatt 2006/09

(21) Anmeldenummer: **04016833.8**

(22) Anmeldetag: **16.07.2004**

(54) **Scheibengalvanisiervorrichtung**

Apparatus for electroplating wafers

appareil de placage de wafer

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: **19.07.2003 DE 10333068**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:

02.03.2005 Patentblatt 2005/09

(73) Patentinhaber: **Rena Sondermaschinen GmbH**

78148 Gütenbach (DE)

(72) Erfinder:

- **Gutekunst, Jürgen**
78120 Furtwangen (DE)

- **Bojan, Vasile-Adrian**

78148 Gütenbach (DE)

(74) Vertreter: **Termin, Erich**

An der Keltenschanze 29
94060 Pocking (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

WO-A-00/32848 **DE-A- 19 923 871**
US-A- 5 405 518 **US-A- 6 080 291**
US-A1- 2003 132 105 **US-A1- 2003 132 118**

EP 1 510 601 B9

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Galvanisieren von sogenannten Wafern. Wafer sind flächenartige geometrische Rundgebilde, die üblicherweise die Basis zur Chipherstellung zur Anwendung im Bereich der Halbleitertechnologie darstellen. Solche Wafer bestehen vorzugsweise aus Halbleitermaterialien der vierten Gruppe des chemischen Periodensystem, zum Beispiel aus Silizium oder Germanium.

[0002] Da die vierte Periodengruppe des chemischen Periodensystems sich in der Mitte zwischen den Metallen der ersten Gruppe und den Nichtmetallen der achten Gruppe des chemischen Periodensystems befindet, sind die Elemente der vierten Periodengruppe weder Ionen leitende Metalle noch Ionen nichtleitende Nichtmetalle, sondern quasi Halbmetalle mit sogenannten Ionen Halbleitereigenschaften.

[0003] Diese Halbleitereigenschaften machte sich die moderne Technologie zu Nutze, wodurch auf kleinstem Raum Funktionen darstellbar sind für die früher tausendfach grössere Raumdimensionen erforderlich waren.

[0004] Wafer sind in der Regel dünne runde Scheiben, im Bereich von zirka einem Millimeter Stärke und einem Durchmesser von Zirka 100 bis 300 mm, die aus sogenannten Einkristallen geschnitten werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist es erforderlich die Waferoberflächen zu behandeln. Das Behandeln der Waferoberfläche kann mechanisch, zum Beispiel durch das Polieren erfolgen, oder durch einen Auftrag von verschiedenartigen Beschichtungen. So kann Die Waferoberfläche beispielsweise parziell oder ganzflächig beschichtet werden. Eine derartige Beschichtung erfolgt in der Regel funktionsbezogen. Die Oberflächenbehandlungen erfolgen beispielsweise mittels Lackier- oder ähnlichen Methoden, insbesondere jedoch, wie im vorliegenden Falle, mittels der Galvanisierungsmethode, wenn Metallschichten auf die Waferoberfläche aufgetragen werden sollen.

[0005] Mittels der Galvanisierungsmethode werden auf die Waferoberfläche Metallschichten aufgetragen die diesen Teil des Wafers leitend machen. Die Galvanisierungsmethode hat den bedeutenden Vorteil, dass die Metallablagerungen auf das Wafer aus wässriger Lösung von in destilliertem Wasser gelösten Metallsalzen erfolgen können. Spezifisch, fachbezogen werden diese Metallsalzlösungen Elektrolytlösungen genannt oder vereinfacht Elektrolyte.

[0006] Die Galvanisierungsmethode bietet die vielfachen Variationsmöglichkeiten für die Gestaltung der Funktionseigenschaften (features) der auf das Wafer aufzutragenden Metallschicht. Da Metallsalze gut wasserlöslich sind können aus den wässrigen Lösungen der Salze die verschiedenen Metalle auf das Wafer aufgetragen werden. Bezüglich der Leitfähigkeitsveränderungseigenschaften, angefangen vom weniger leitfähigen Chrom bis zu den gut leitfähigen Metallen wie Kupfer, Silber oder Gold.

[0007] Das Galvanisierungsverfahren ist optimal an-

wendbar, weil einige Parameter der Verfahrenstechnologie weitgehend komplikationslos variierbar sind und diese Parameter eine Auswirkung auf die Struktur der Metallbeschichtung haben.

5 **[0008]** Diese Parameter sind beispielsweise; die Konzentration des Salzgehaltes der Elektrolytbäder, die Stromdichte und Stromspannung der über die Kathode und Anode aus einer elektrischen Stromquelle zugeführten Prozessenergie und die Elektrolytbadtemperatur.

10 **[0009]** Die Galvanisierungstechnologie ist hinreichend bekannt, besitzt ein umfangreiches Anwendungsspektrum und braucht hier nicht weiter abgehandelt werden. Die Wafergalvanisierungstechnologie dagegen ist ein spezielles Anwendungsgebiet der Galvanisierung. Deren Vorzüge haben sich in der Praxis bewährt. Die angewandten und bekannten Wafergalvanisiervorrichtungen die den Stand der Technik darstellen, sind solche, wie sie beispielhaft mit der Figur 1 beschrieben sind.

20 **[0010]** Zum Stande der Technik relevante Publikationen mit technischem Hintergrund werden wie folgend abgehandelt.

25 **[0011]** Die US 2003/132105 A1 beschreibt eine Waferhalterung zum Zwecke des Elektropolierens, bestehend aus einer oberen und einer unteren Halterungssektion mit einem dazwischen liegendem Zweikomponenten-Elektrolytabdichtungssystem, einer Feder **306** und einem verschiedenartig geformten Elektrolyt-Abdichtungselement **310**.

30 **[0012]** Die US 2003/132118 A1 beschreibt eine Vorrichtung zum Elektropolieren von rotierenden Waferscheiben in einer hermetisch geschlossenen Vorrichtung. Die Abdichtung der oberen hin zur unteren Vorrichtungskomponente erfolgt mittels einer regulär gebräuchlichen Dichtung die keine spezifischen Merkmale aufweist.

35 **[0013]** Das US Patent 6,080,291 beschreibt eine Vorrichtung zum Elektropolieren von rotierenden Waferscheiben. Um eine gleichmässige Stromzufuhr zur Waferscheibe zu gewährleisten, erfolgt der Stromzufuhrkontakt ringförmig auf die Waferscheibe und dementsprechend auch die Elektrolytabdichtung. Die ringförmige speziell geformte Dichtung besitzt eine Gleitlippe die an die Unterseite der Waferscheibe gedrückt wird und so die Abdichtung bewirkt.

40 **[0014]** Das WO 00/32848 beschreibt ein hydraulisches beziehungsweise pneumatisches System zur Elektrolytabdichtung wobei mittels dem Druck von oben auf die Waferscheibe diese gegen einen Stromzufuhrkontakt ring gedrückt wird.

45 **[0015]** Das US Patent 5,405,518 beschreibt einen Werkstückfixierer für runde scheibenförmige Werkstücke und ein System zum elektrochemischen Gravieren von Werkstücken. Das Dichtungssystem ist zum Zwecke der Minimierung des Bruchs der Werkstücke konzipiert und besteht wie in Figur 3 dieses Patents gezeigt, aus einem indirekten Dichtungsandrucksystem mit Doppelringfunktion oder wie in Figur 5 des Patents gezeigt aus

zwei Konterdichtungsringen die an das Werkstück und die Stromzufuhrelektrode gedrückt werden.

[0016] Die DE-OS 199 23 871 A1 zeigt eine dynamisch operierende Abdichtungseinrichtung zum Zwecke der Vermeidung des Anhaftens des Dichtungsmaterials an dünne Scheiben, speziell konzipiert für die Halterung von Silizium-Wafern.

[0017] Problematisch ist generell bei den bekannten Wafergalvanisierungsvorrichtungen der Abdichtungsbe-
reich des Galvanisierungsbad zwischen Waferober-
seite und Waferunterseite.

[0018] Die gemäß dem Stand der Technik zitierten Pu-
blikationen konnten für den Fachmann keinen Beitrag
zur vorliegenden Erfindung leisten, da die Aufgabenstel-
lungen die den relevanten Publikationen zu Grunde la-
gen verschiedenartig und nicht konform zur vorliegenden
Erfindung sind.

[Streichung(en)]

[0019] Die Abdichtung erfolgt üblicherweise mittels ein-
nem Abdichtungsring 3. Die Abdichtung zum Elektrolyt-
bad gemäß dem Beispiel der Figur 1 erfolgt mittels einem
O-ring 18. Gleichzeitig hat der O-ring 18 eine Art Gleit-
spaltführungsfunktion im Gleitspalt 21. Die Montage des
O-rings 18 kann jedoch, was nachteilig ist, nur im Trok-
kenzustand erfolgen, somit bei leerem Galvanisations-
bad. Bei Mehrfachmanipulation wird das System des-
halb, wegen dem Trocken-Nass-Wechsel, zwangsläufig
anfällig auf Sickerläckagen des Elektrolytes. Die vorhan-
denen Temperaturdifferenzen spielen bei den verschie-
denen spezifischen Temperaturdehnungskoeffizienten
der eingesetzten Vorrichtungselemente eine bedeuten-
de Rolle. Die erforderliche 100%-ige Dichtesicherheit
verursacht, deshalb im Falle von Undichtheiten im Vor-
richtungssystem, Prozessunterbrechungen.

[0020] Bekanntlich leidet dann, wie bei allen Prozes-
sunterbrechungen, während dem Wiederanfahren die
Produktqualität der ersten Produktpartie.

[0021] Eine nachhaltig, gleichbleibende Produktquali-
tät ist dann nicht gegeben und prozentual betrachtet,
schlagen beim kostspieligen Rohmaterial der vorliegen-
den zu galvanisierenden Wafer, Fehlproduktionen, von
der Kostenseite her, stark zu Buche. Eine insbesondere
Schwachstelle, wie in Figur 1 zum Stande der Technik
gezeigt, ist der Seitenspielraum zwischen dem Abdich-
tungsring 3 und der Vorrichtungsbasis 1. Die Abdichtung
zwischen diesen Vorrichtungsteilen mittels dem relativ
grossdimensionierten O-ring 18 hat den Nachteil, dass
der O-ring zum rollen neigt oder beim Hin- und Herma-
nipulieren des Abdichtungsring 3, bis zur dessen Fixie-
rung in der finalen Position, Reibungen der O-Ringober-
fläche zur Beschädigung des Rings führen können, mit
der Folge, von danach auftretenden Elektrolytläckagen.
Generell gesehen, ist der Seitenspielraum, Spalt 21, zwi-
schen dem Abdichtungsring 3 und der Vorrichtungsbasis
1 eine Systemschwachstelle. Das Einsetzen des O-rings
18 ist darüberhinaus kompliziert, weil der O-ring 18 beim
Einfügen in dessen Ringnut stark gestreckt werden muß
und es auch bei dieser Manipulation zur O-ringbeschä-

digung kommen kann.

[0022] Aufgabe der Erfindung war es deshalb eine
spezielle Galvanisierungsvorrichtung zu entwickeln, die
es gestattet, das Galvanisieren von Waferscheiben der-
art zu gestalten, dass eine sichere Abdichtung inbezug
auf das Elektrolytdurchsickern zwischen dem Wafer-
oberbereich und dem Waferunterbereich gegeben ist.
Des weiteren muß die Montage des Abdichtungssystems
einfach manipulierbar und derart konzipiert sein, dass
die Passgenauigkeit zwischen den einzelnen Vorrich-
tungselementen untereinander derart harmonisiert, dass
keine Seitenspielräume, wie Spalt 21, vorhanden sind.
Ferner müssen die elastischen eigentlichen Abdich-
tungselemente, nämlich elastische O-ringe, nur in verti-
kaler Linie positionierbar sein, um Reibungsmöglichkei-
ten auf der O-ringoberfläche von vornherein auszu-
schliessen.

[0023] Die O-ringe sollen im Zuge der Vorrichtungs-
montage nach deren Einlegen in die vorgesehenen Räu-
me, nicht mehr mechanisch tangiert werden.

[0024] Im Zuge der inzwischen gängigen 300 mm
Durchmesser Wafertechnologie ist es erforderlich, dass
die Passgenauigkeiten der Galvanisiervorrichtungsele-
mente zueinander derart harmonisieren, dass Seitenver-
kantungen wegen eventuell vorhandener Seitenspiel-
räume, wie beispielsweise in Figur 1, Spalt 21, ausge-
schlossen sind. Es ist unbedingt erforderlich, dass die
O-ringpositionierung durch leichtes Einlegen in die Ein-
legemulden problemlos vonstatten geht. Dies muß
selbstverständlich auch für andere Waferdurchmesser
gewährleistet sein. Insbesondere aber waren die her-
ausfordernden technologischen Prozessbedingungen
bei der neuen Generation von Waferscheiben mit einem
Durchmesser von 300 mm zu erfüllen, wo die Vorrich-
tungspassgenauigkeit der einzelnen Vorrichtungsele-
mente zueinander von besonderer Bedeutung ist. Die
Passgenauigkeit von Abdichtungsring 3 samt integrier-
tem O-Ring, beziehungsweise O-ringen, im Verhältnis
zur Vorrichtungsbasis, muß auch unter Berücksichtigung
der dimensionsbedingten höheren Material-Temperatur-
dehnungsschwankungen **[Streichung(en)]** derart ge-
währleistet sein, dass ein Verschleiß des Abdichtungs-
systems und insbesondere der O-Ringe samt O-ringpas-
sagen absolut minimiert ist.

[0025] Die Aufgabe wurde gelöst durch eine Galvani-
siervorrichtung zum galvanisieren von Waferscheiben,
bestehend aus; einer Vorrichtungsbasis mit Innengewin-
de 1, einer Überwurfmutter 4, zur Befestigung und Fixie-
rung des Gesamtsystems der Vorrichtung, einem Adap-
ter 5, als Aufnahmebasis für die zu galvanisierenden
Waferscheiben und Abdichtungselementen zum Abdich-
ten des Elektrolytbereichs, die dadurch gekennzeichnet
ist;
dass die Galvanisiervorrichtung einen oberen Abdich-
tungsring (3) besitzt, an dessen beiden Enden je eine O-
ringeinlegemulde situiert ist, für die einlegbaren O-ringe
(6), am oberen Ende des Abdichtungsring (3) und O-
ring (7), am unteren Ende des Abdichtungsring (3) und

die Galvanisiervorrichtung ein weiteres unteres Abdichtungselement (10) besitzt, in der Form eines Rings oder einer Rundscheibe, mit jeweilig einer als Gegenpart zum oberen Abdichtungsring (3) positionierten Kontermulde für die Einlegbarkeit des unteren O-rings (7) und der Abdichtungsring (3) und die Abdichtungselemente (10), seitenspielfraumfrei in der Basis (1) beziehungsweise dem Zwischenteil (16) eingesetzt, bei eingelegten O-ringen (6) und (7), gegeneinander gedrückt werden, wodurch ein in sich geschlossener, elektrolytdichter Bereich vorhanden ist.

[0026] Das Andrücken des unteren Abdichtungsringes gegen den oberen Abdichtungsring kann alternativ, mittels der Überwurfmutter 4 erfolgen wenn der Vorrichtungsboden, mit zwischengeschalteten elastischen Pufferelementen 8, wie im Beispiel der Figur 2 und 3 gezeigt, als Druckkonterpart für den Abdichtungsring 10 dient. Sicherheitshalber ist in solchem Falle eine Faltenbalgabdichtung zwischen Abdichtungsring 10 und Vorrichtungsbasis geschaltet.

[0027] Der Faltenbalg kann beliebig, vertikal oder horizontal eingesetzt werden und besteht in der Regel aus Gummi oder gummiertem Textilmaterial.

[0028] Das Faltenbalgabdichtungssystem kann, wenn der Faltenbalg 9 im Doppel konzipiert ist und dadurch eine Kammer bildet, auch als Kanal 14 für pneumatische oder hydraulische Druckmedien zum Andrücken des unteren Abdichtungsringes 10 dienen, wie dies in Figur 6 gezeigt wird.

[0029] Beim rundflächigen unteren Abdichtungsring 10 als Alternative zum offenen Abdichtungsring 10, kann das Andrücken desselben gegen den oberen Abdichtungsring 3, wie dies in Figur 7 gezeigt wird, unter Anwendung einer flexiblen Membran 17, alternativ zu Figur 4, mittels pneumatischen beziehungsweise hydraulischen Druckmedien erfolgen.

[0030] Weitere Kombinationen sind unter Anwendung der Scheibengalvanisiervorrichtung, gemäß der Erfindung, zum Beispiel wie dies in Figur 5 gezeigt wird, mit anderer Raumkonfiguration möglich.

[0031] Die nachfolgenden Figuren beschreiben die Erfindung beispielhaft im Detail. Zwecks ausführlicher Erläuterung der Erfindungshöhe wird mit Figur 1 beispielhaft eine Vorrichtung zum bisherigen Stand der Technik gezeigt.

[0032] Die Figuren 2 bis 7 beschreiben beispielhaft die verschiedenen erfinderischen Vorrichtungsvarianten.

Fig.1 zeigt vergleichsweise beispielhaft den Stand der Technik einer Wafergalvanisiervorrichtung B.

Zur Abdichtung des Elektrolytbereichs und gleichzeitiger Zentrierung der Waferscheibe wird ein O-ring 18 eingesetzt der, des weiteren, den Spalt 21 des Montagesystems schließt. Durch das Auf- und Abbewegen während der Montage der Vorrichtungselemente, insbesondere des Abdichtungsringes 3, besteht die Gefahr

der Bildung von Reibungsritzen am O-ring 18 und damit verbunden die Gefahr des Durchsickerns von Elektrolytflüssigkeit. Des weiteren ist der Seitenbewegungsspielraum im Spalt 21 zu groß um die Randerfassung der Waferscheibe exakt gleichbeibend galvanisieren zu können. Die Waferscheibenzentrierung wird somit nicht gut genug vollzogen. Die Montage des O-rings 18 in den Nut des Zwischenteils 16 ist nicht komplikationslos, da um den O-ring 18 in die Nut einzusetzen, muß der O-ring stark gestreckt werden. Dadurch besteht die Gefahr der Deformierung des O-Rings und gegebenenfalls, der Beschädigung des O-Rings durch Reibungsritzen.

Fig.2 zeigt die Scheibengalvanisiervorrichtung A, beispielhaft gemäß der Erfindung, mit dem Abdichtungsring 3, der an deren beiden Enden mit je einer Mulde versehen ist. In diesen Mulden sind die O-ringe 6 und 7 eingelegt, beziehungsweise kann der O-ring 7 in die Mulde von Abdichtungsring oder Abdichtungsscheibe 10 gelegt werden. Der Abdichtungsring 3 wird seitenspielfraumfrei und exakt zentriert an das Zwischenteil 16 montiert.

Gegenpart zum Abdichtungsring 3, zur Abdichtung des Elektrolytbereichs sind der untere Abdichtungsring beziehungsweise die Abdichtungsscheibe 10, mit im Randbereich situierter O-ringmulde, jeweils kontrabezogen zur unteren Ringmulde des Abdichtungsringes 3. Im Falle der Anwendung eines unteren Abdichtungsringes 10, ist dieser mittels einem elastischen Faltenbalg, zwecks der Elektrolytabdichtung, mit der Vorrichtungsbasis verbunden. Im Falle von Figur 2, mit einem Faltenbalg 9 in waagerechter Position. Zwischen Abdichtungsring 10 und der Vorrichtungsbasis 1 ist ein pufferndes, elastisches Ringelement 8 situiert, zum Zwecke der Spannungsnivellierung des gesamten Vorrichtungselementesystems.

Fig.3 zeigt eine Variante der Vorrichtungsgestaltung C, wie in Figur 2, unter Anwendung eines offenen unteren Abdichtungsringes 10. Der Abdichtungsring 10 ist mittels einem senkrechten Faltenbalg 9 mit der Vorrichtungsbasis verbunden um die Elektrolytdichtheit zu gewährleisten. Der elastische Puffering 8 ist entsprechend in Stützformation höher und gestattet zusammen mit dem senkrechten Faltenbalg eine, für Bedarfsfälle, höhere Vorrichtungsgestaltung. Bei dieser Vorrichtungsvariante erfolgt der Elementeverbunddruck auf die beiden O-ringe 6 und 7 mittels der Überwurfmutter 4.

Fig.4 zeigt eine Vorrichtungsvariante D, unter Anwen-

derung einer geschlossenen vollflächigen Abdichtungsscheibe 10, als Konterpart zum Abdichtungsring 3. Der O-ring 7 wird vorzugsweise in die O-ringmulde der Abdichtungsscheibe 10 eingelegt. Zum Abfedern der Andruckkraft auf die Scheibe 10, kommt ein abpufferndes elastisches Ringelement 12 zum Einsatz.

Das Andrücken der Abdichtungsscheibe 10 an den Abdichtungsring 3 mit den einliegenden O-ringen 6 und 7 erfolgt mittels einer Druckvorrichtung 11, die mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch betrieben werden kann.

Fig.5 zeigt eine Vorrichtungsvariante E, als Kombination der Figuren 3 und 4 mit einem Höhenvariationszwischenelement 13 zur Höhendimensionvariation der Gesamtvorrichtung.

Fig.6 zeigt eine Vorrichtungsvariante F mit beiderseitigem Faltenbalg 9, der in dieser Form einen geschlossenen Kanal 14 bildet, der neben der Funktion als Elektrolytabdichtungselement, gleichzeitig einen Kanal 14 darstellt, für die Zuleitung der Hydraulik- beziehungsweise Pneumatikmedien als Druckmedien beim regulierten Andrücken des unteren Abdichtungsringes 10, an den oberen Abdichtungsring 3. Diese Variante hat den Vorteil, dass die beiden O-Ringe 6 und 7, nach deren Vorfixierung, keiner weiteren mechanischen Manipulation unterworfen sind, insbesondere, weil das O-ringsystem stets in vertikaler Richtung belastet wird. Der Abdichtungsdruck auf die beiden O-Ringe 6 und 7 erfolgt in diesem Falle dynamisch. Die O-ringe unterliegen somit keiner Reibungsbelastung.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass bei einer Prozessänderung oder einem sonstigen erforderlichen Prozessunterbruch die O-ringe leicht dem System entnommen werden und wieder leicht eingesetzt werden können. Der O-ringverschleiß ist damit sehr gering.

Diese Variante trägt noch mehr zur Abdichtungssicherheit des Elektrolytmediums bei.

Fig.7 zeigt eine Vorrichtungsvariante G, eine Kombinationsvariante auf der Basis der Figuren 2 und 6.

Durch die Anwendung einer Flächenmembran 17 wird der Druck auf die Bodenfläche der Abdichtungsscheibe 10 am gleichmässigsten übertragen. Damit wird die schonendste und gleichmässigste Druckverteilung einwirkend auf die beiden Abdichtungsringe 6 und 7 erreicht. Hinzu kommt noch die puffernde Wirkung der elastischen Elemente 8. Alle Elemente der gesamten Galvanisiervorrichtung werden somit ideal zentrisch verbunden und dynamisch

verspannt.

Die neue Scheibengalvanisiervorrichtung stellt einen bedeutenden Zugewinn zum technischen Fortschritt dar. Durch die erzielbare Minimierung von Fehlproduktionen durch die optimale zentrische Randerfassung der zu galvanisierenden Wafer wird auch ein erheblicher Beitrag zur Umweltentlastung geleistet.

[0033] Die Produktion von Einkristallsilizium beziehungsweise Einkristallgermanium oder anderer Halbleitereinkristallvarianten ist energieintensiv und im Zusammenhang mit der einhergehenden Zwischenproduktherstellung sind intensive Entsorgungsmassnahmen zur Umweltentlastung beim Anfall von Fehlproduktionen erforderlich.

[0034] Die Erfindungshöhe besteht insbesondere in der vertikalen Systemmontage der erfinderischen Vorrichtung. Dadurch erfolgt der Spannungsdruck der montierten Systemelemente vertikal-geradlinig. Dementsprechend kann die Montage der einzelnen Elemente nach dem Einlegeprinzip erfolgen.

[0035] Durch die exakte vertikalzentrierte Montage der Elemente erfolgt die Randgalvanisierung der Wafer gleichbleibend und fehlerfrei. Die Fehlproduktionsrate und damit die Stückproduktivität wird erheblich gesteigert.

[0036] Die mit den Figuren dargestellten Beispiele sind als solche zu verstehen. Die Erfindung birgt weitere beispielhafte Anwendungsvarianten in sich und zwar generell in der Galvanisationstechnik von flächigen Substraten.

Bezugszeichenliste

[0037]

- 1 Vorrichtungsbasis (Substrataufnahme)
- 2 Wafer (Galvanisierungssubstrat)
- 3 Abdichtungsring
- 4 Überwurfmutter
- 5 Adapter
- 6 Oberer O-ring
- 7 Unterer O-ring
- 8 Elastisches Pufferelement als Stütze bei Höhenvariation
- 9 Faltenbalg
- 10 Unterer Abdichtungsring beziehungsweise Fläche
- 11 Druckelement
- 12 Elastisches Element wie 8
- 13 Höhenvariationszwischenelement
- 14 Druckmedienkanal
- 15 Doppelter Faltenbalg
- 16 Zwischenteil
- 17 Elastische Membran
- 18 O-ring zum Stand der Technik
- 19 Druckausübendes Medium
- 20 Stromzuführung

- 21 Spalt zwischen 1 und 3
 A Galvanisiervorrichtung gemäß dem Stande der Technik
 B bis G Erfinderische Varianten der Galvanisiervorrichtung

Patentansprüche

1. Galvanisiervorrichtung zum Galvanisieren von Waferscheiben, bestehend aus; Vorrichtungsbasis mit Innengewinde (1), einer Überwurfmutter (4), zur Befestigung und Fixierung des Gesamtsystems der Vorrichtung, einem Adapter (5), als Aufnahmebasis für die zu galvanisierenden Waferscheiben und Abdichtungselementen zum Abdichten des Elektrolytbereichs,
dadurch gekennzeichnet, dass;
 die Galvanisiervorrichtung einen oberen Abdichtungsring (3) besitzt, an dessen beiden Enden je eine O-ringeinlegemulde situiert ist, für die einlegbaren O-ringe (6), am oberen Ende des Abdichtungsring (3) und O-ring (7), am unteren Ende des Abdichtungsring (3) und die Galvanisiervorrichtung ein weiteres unteres Abdichtungselement (10) besitzt, in der Form eines Rings oder einer Rundscheibe, mit jeweilig einer als Gegenpart zum oberen Abdichtungsring (3) positionierten Kontermulde für die Einlegbarkeit des unteren O-rings (7) und der Abdichtungsring (3) und die Abdichtungselemente (10), seitensspielraumfrei in der Basis (1) beziehungsweise dem Zwischenteil (16) eingesetzt, bei eingelegten O-ringen (6) und (7), gegeneinander gedrückt werden, wodurch ein in sich geschlossener, elektrolytdichter Bereich vorhanden ist.
2. Galvanisiervorrichtung, nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Gegeneinanderdrücken eines der Abdichtungselemente (10) gegen den Abdichtungsring (3), bei eingelegten O-ringen, mittels Anwendung von pneumatischen beziehungsweise hydraulischen Drucksystemen erfolgt.
3. Galvanisiervorrichtung, nach den Ansprüchen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Anwendung der pneumatischen oder hydraulischen Drucksysteme unter Anwendung eines Abdichtungsring (10) mit eingelegtem O-ring (7) als unteren Konterpart zu Abdichtungsring (3), die Zuführung der Druckmedien der hydraulischen beziehungsweise pneumatischen Druckmedien, mittels einem Durchlaufkanal (14) bestehend aus einem abdichtenden Doppelfaltenbalg (15) erfolgt.
4. Galvanisiervorrichtung, nach den Ansprüchen 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, dass bei Anwendung der pneumatischen Drucksysteme unter Anwendung einer Abdichtungsscheibe (10) mit eingelegtem O-ring (7) als unteren Konterpart zu Abdichtungsring (3), die Zuführung der Druckmedien der hydraulischen beziehungsweise pneumatischen Druckmedien auf eine flexible Membran (17), flächenbezogen erfolgt, wodurch der Abdichtungsring (3) und die Abdichtungsscheibe (10) dynamisch und integral gleichmäßig gegeneinander gedrückt werden.

5. Galvanisiervorrichtung, nach den Ansprüchen 1, 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die regulierte Druckmedienzufuhr mittels einem Regelaggregat erfolgt, das die O-ringbelastung derart berücksichtigt, dass der O-ring nicht deformiert wird wodurch eine optimale Abdichtung gewährleistet ist.
6. Galvanisiervorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** Stütz-Pufferelemente (8) und (12) eingesetzt werden, die die Belastung der O-Ringe beim Verspannen abfedern und eine höhendifferenzierte Vorrichtungsgestaltung begünstigen.
7. Galvanisiervorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** bei den variablen und unterschiedlichen Vorrichtungsgestaltungsmöglichkeiten, Faltenbalgsysteme (9) zur Abdichtung des Elektrolytbereichs eingesetzt werden

Claims

1. Electroplating device for electroplating wafers, consisting of: device base with internal thread (1), a union nut (4) for fastening and fixing the overall system of the device, an adapter (5) as take-up base for the wafers to be electroplated and sealing elements for sealing the electrolyte area, **characterised by** the fact that:

the electroplating device has an upper seal ring (3) at both ends of which there is an O-ring insertion groove for the insertable O-rings (6) on the upper end of the seal ring (3) and O-ring (7) at the lower end of the seal ring (3),
 and by the fact that the electroplating device has another lower seal element (10) in the form of another ring or a round disc featuring in each case a counter groove positioned as counter part to the upper seal ring (3) for the insertability of the lower O-ring (7),
 and by the fact that the seal ring (3) and the seal elements (10) are, if they are inserted in the base

(1) or the connecting piece (16) without lateral clearance, and if the O-rings (6) and (7) are inserted, pushed against each other, whereby a closed, electrolyte-tight area is generated.

2. Electroplating device, according to claim 1, **characterised by** the fact that the pushing of one of the seal elements (10) against the seal ring (3), with inserted O-rings, is caused by the application of pneumatic or hydraulic pressure systems.
3. Electroplating device, according to claims 1 and 2, **characterised by** the fact that in using the pneumatic or hydraulic pressure systems using a seal ring (10) with inserted O-ring (7) as lower counter part to seal ring (3), the pressure media of the hydraulic or pneumatic pressure media are fed via a pass-through channel (14) consisting of sealing double fold bellows (15).
4. Electroplating device, according to claims 1 and 2, **characterised by** the fact that in using the pneumatic or hydraulic pressure systems using a seal ring (10) with inserted O-ring (7) as lower counter part to seal ring (3), the pressure media of the hydraulic or pneumatic pressure media are fed on a flexible membrane (17), in an area-related way, which leads to the seal ring (3) and the gasket (10) being pushed against each other dynamically und integrally evenly.
5. Electroplating device, according to claims 1, 3 and 4, **characterised by** the fact that the regulated fed of the pressure media is effected using a regulating aggregate which considers the O-ring load so that the O-ring is not deformed; thus, optimal sealing is guaranteed.
6. Electroplating device according to claim 1, **characterised by** the fact that supporting cushioning elements (8) and (12) are used which absorb the load of the O-rings in constraining and favour a height-differentiated device design.
7. Electroplating device according to claim 1, **characterised by** the fact that fold bellows systems (9) are used for sealing the electrolyte area in the variable and different device design possibilities.

Revendications

1. Dispositif de galvanisation destiné à la galvanisation de tranches de silicium composé: d'un support pour le dispositif avec filetage intérieur (1), d'un écrou-raccord (4) pour l'attache et la fixation de l'intégralité du système du dispositif, d'un adaptateur (5) servant de support de réception pour la tranche de silicium

à galvaniser et d'éléments étanches servant à étancher la zone d'électrolyte,
caractérisé en ce que :

- le dispositif de galvanisation possède un anneau étanche supérieur (3) sur les deux faces duquel est situé un évidement destiné à recevoir des joints toriques insérés, l'un se trouvant sur la face supérieure de l'anneau étanche pour recevoir le joint torique (6) et l'autre se trouvant sur la face inférieure de l'anneau étanche pour recevoir le joint torique (7), que le dispositif de galvanisation possède un autre anneau étanche inférieur (10) ayant la forme d'un anneau ou d'un disque disposant chacun d'un contre-évidement positionné en face de l'évidement de l'anneau étanche supérieur (3) et destiné à recevoir le joint torique inférieur (7) et que l'anneau étanche (3) et les éléments étanches (10) sont insérés dans le support (1) ou la partie intermédiaire (16) sans jeu latéral pressant ainsi les joints toriques (6) et (7) l'un contre l'autre pour garantir une zone close et étanche à l'électrolyte.
2. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la compression de l'un des éléments étanches (10) contre l'anneau étanche (3), joints toriques insérés, s'effectue au moyen de systèmes de pression pneumatique voire hydraulique.
3. Dispositif selon les revendications 1 et 2, **caractérisé en ce que**, lors de l'utilisation des systèmes de pression pneumatique ou hydraulique avec un anneau étanche (10) et un joint torique (7) inséré en tant que contrepartie inférieure à l'anneau étanche (3), l'alimentation en fluide de pression hydraulique ou pneumatique s'effectue par le biais d'un canal continu (14) composé d'un soufflet double (15) étanche.
4. Dispositif selon les revendications 1 et 2, **caractérisé en ce que**, lors de l'utilisation des systèmes de pression pneumatique avec un disque étanche (10) et un joint torique (7) inséré en tant que contrepartie inférieure à l'anneau étanche (3), l'alimentation en fluide de pression hydraulique voire pneumatique s'effectue en fonction de la surface sur une membrane flexible (17), ce qui permet de presser l'anneau étanche (3) et le disque étanche (10) l'un contre l'autre de manière dynamique et intégralement homogène.
5. Dispositif selon les revendications 1 et 3 et 4, **caractérisé en ce que**, l'alimentation régulée en fluide de pression s'effectue par le biais d'une unité de régulation qui respecte le domaine de charge des joints toriques de telle

manière que les joints toriques ne sont pas déformés, ce qui garantit une étanchéité optimale.

6. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que,** 5
les amortisseurs de soutien (8) et (12) sont utilisés pour amortir la charge à laquelle sont soumis les joints toriques lors de la tension et pour favoriser une configuration différentiable en hauteur du dispositif. 10
7. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que,**
des systèmes de soufflet (9) sont utilisés pour étancher la zone d'électrolyte dans les différentes possibilités de configuration du dispositif. 15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig.1

B

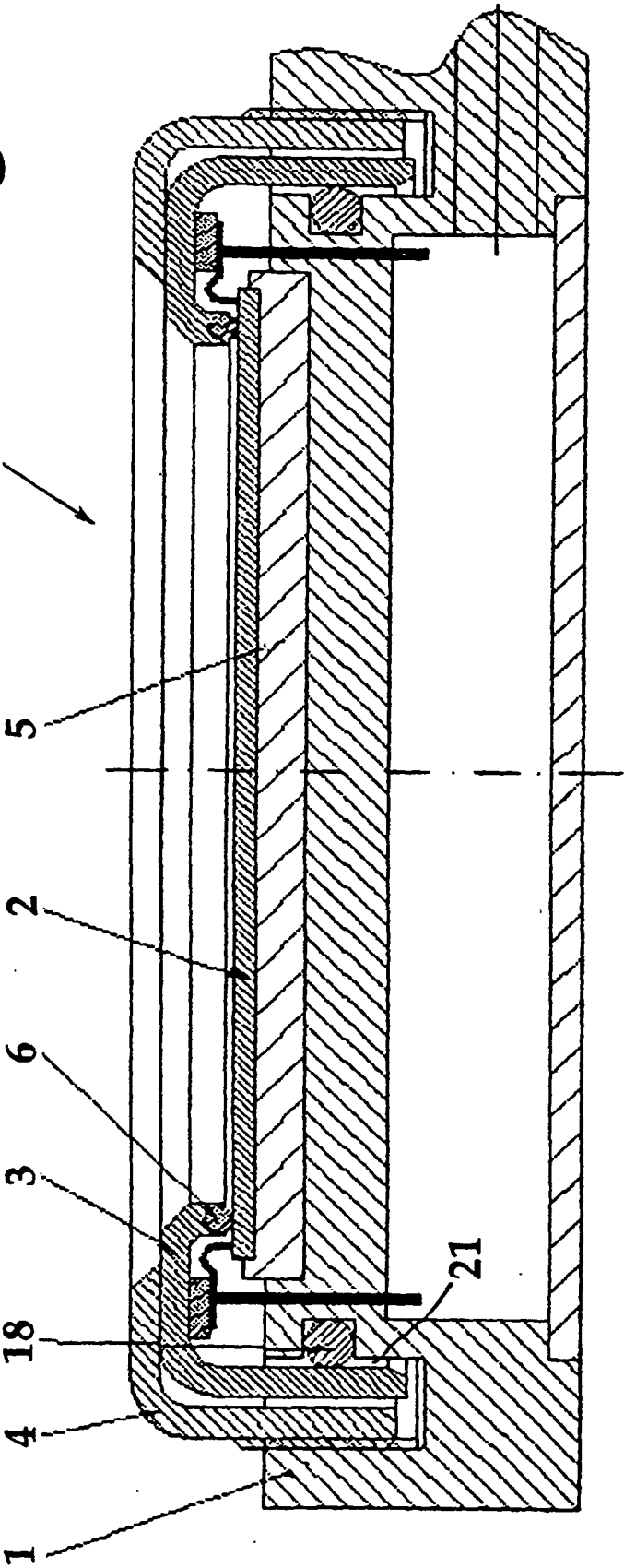


Fig.2

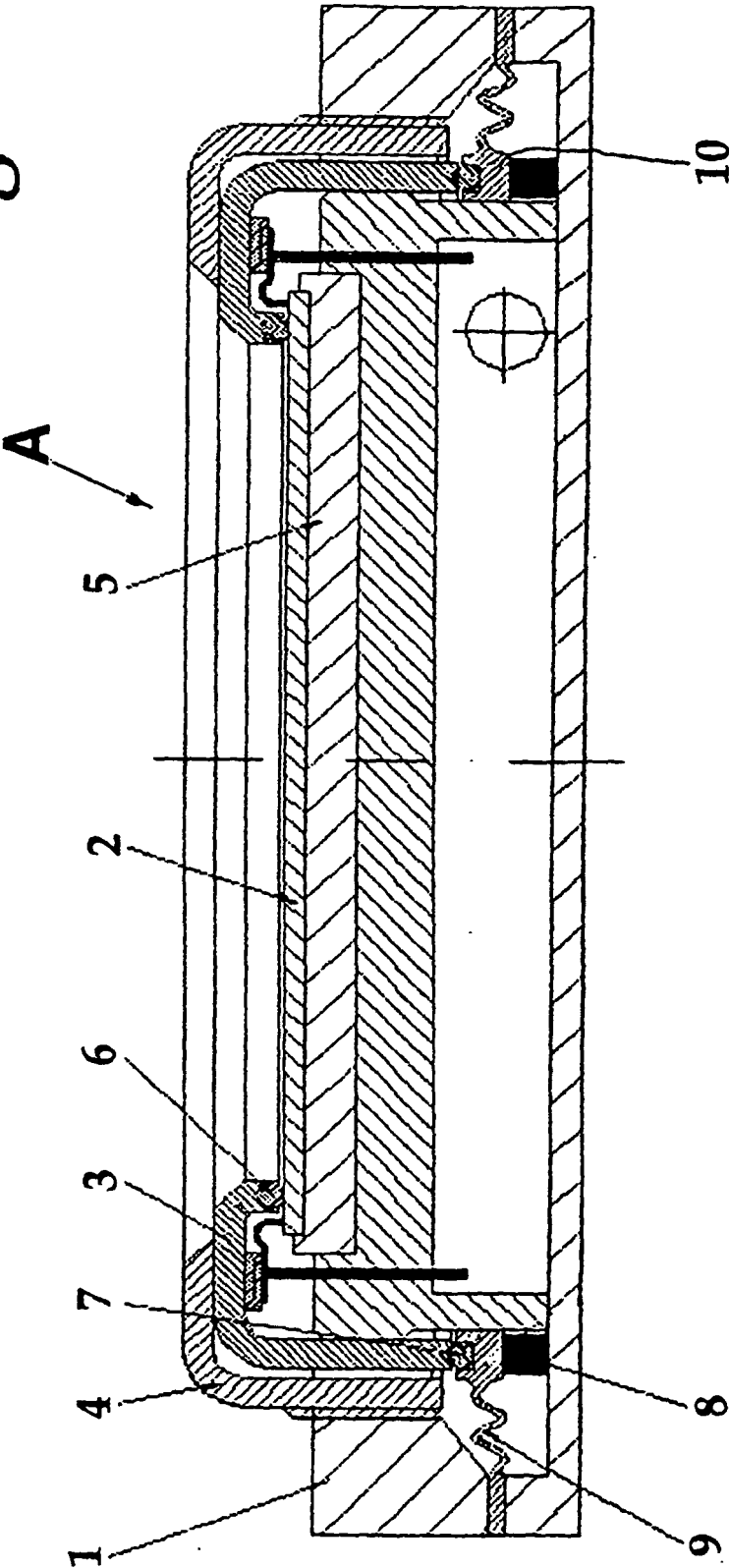


Fig.3

C

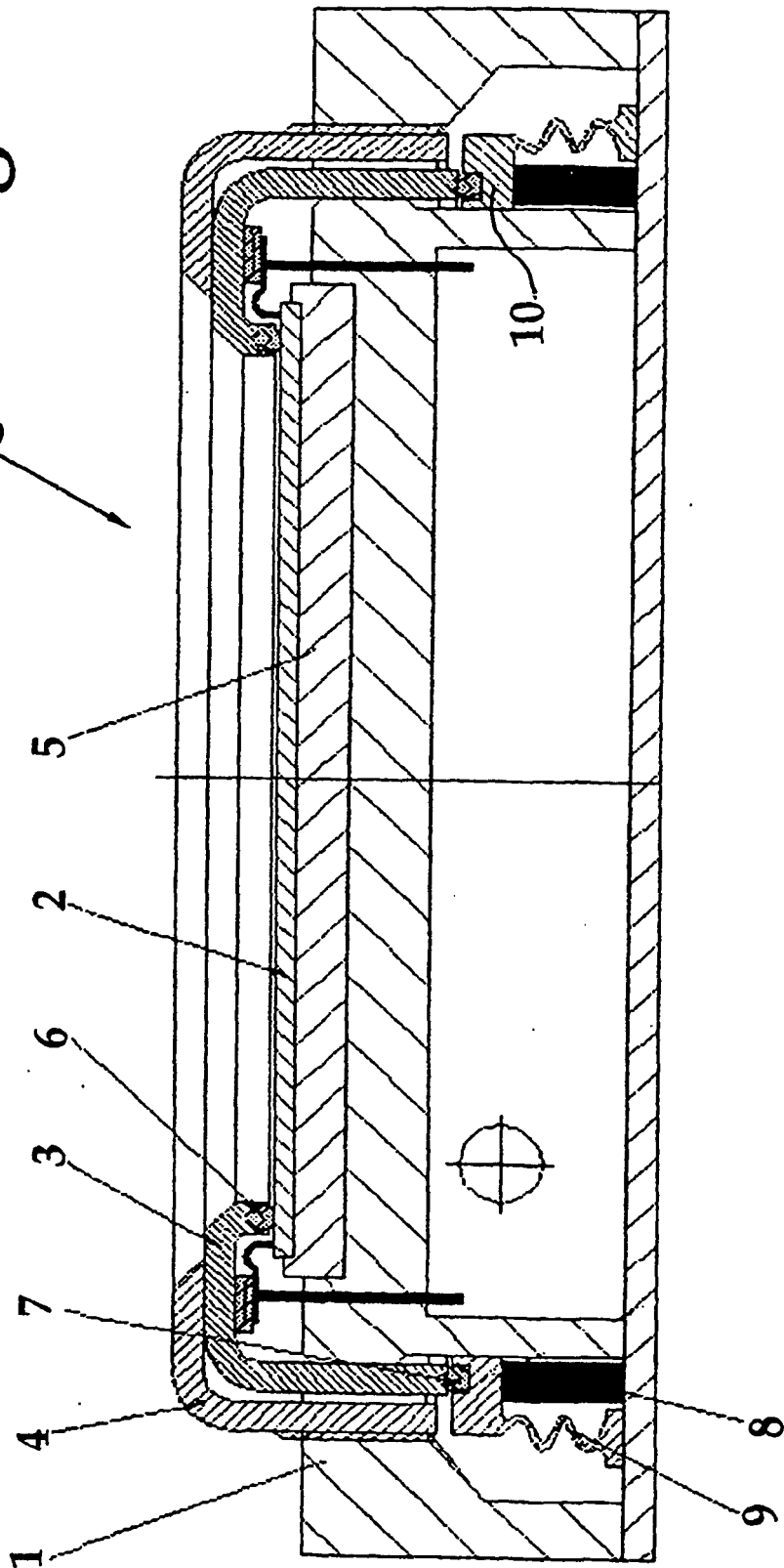


Fig. 4

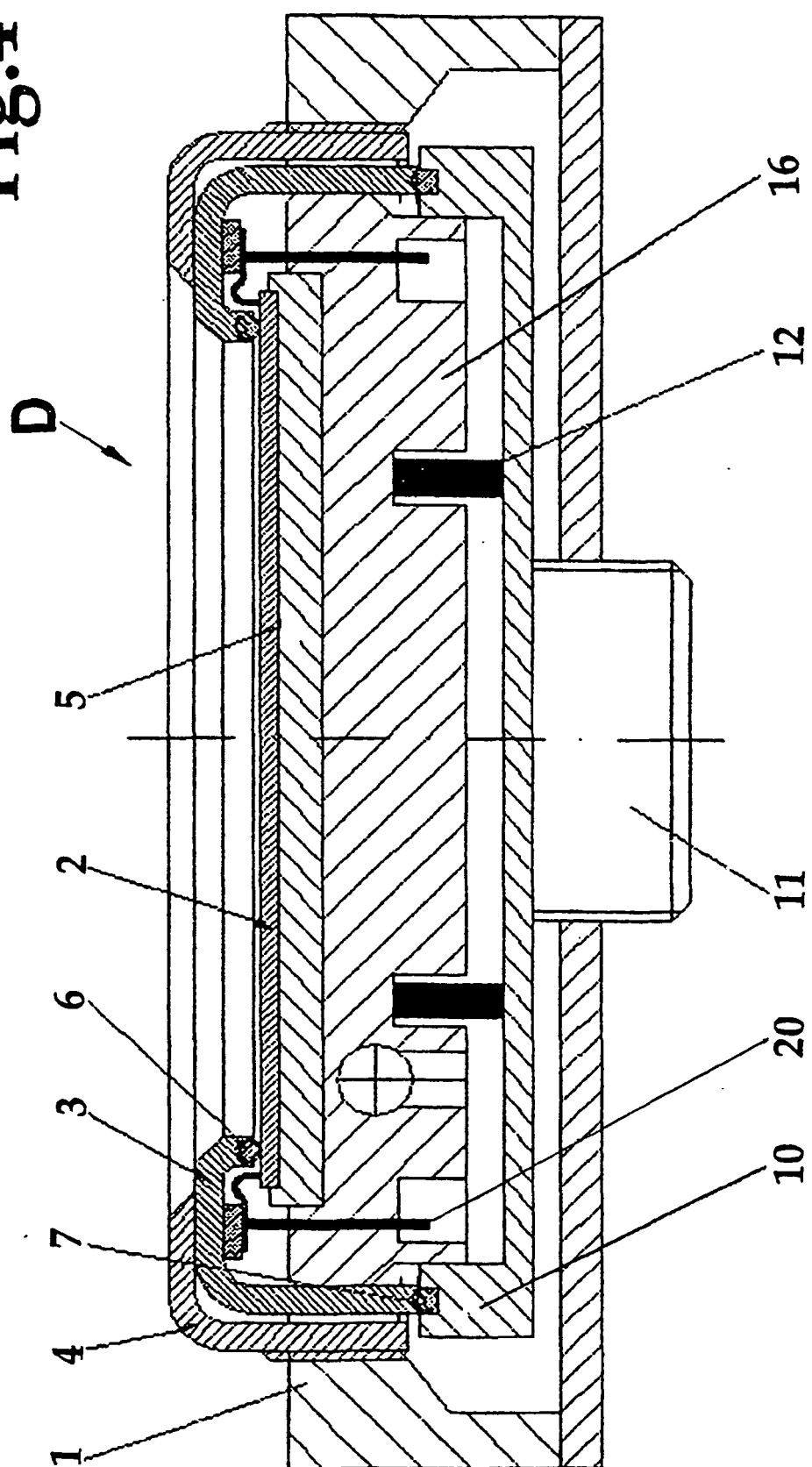


Fig.5

E ↗

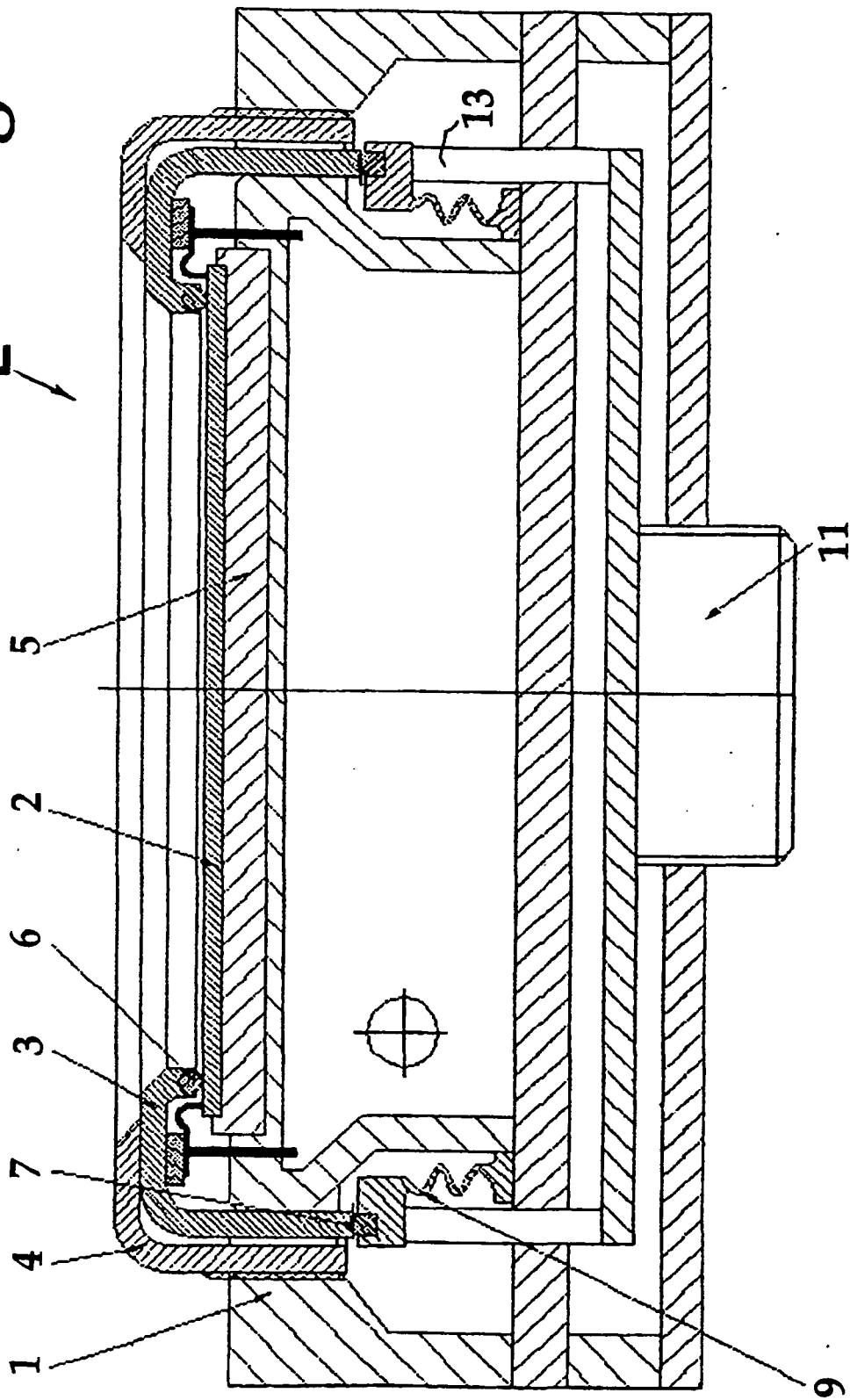


Fig.6

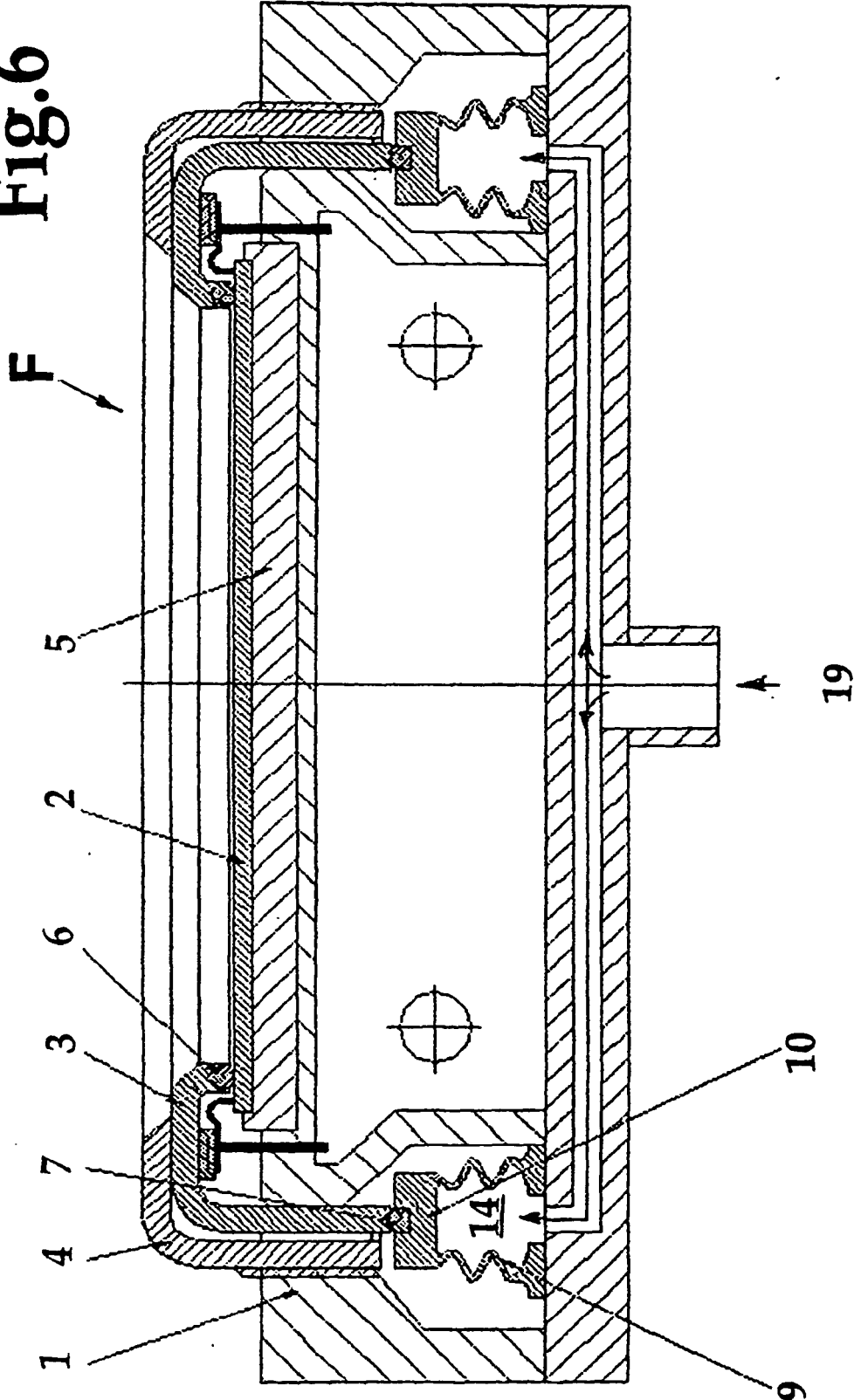


Fig.7

G

